

SK keyfoundry推出第四代0.18微米BCD工艺

为提高移动和汽车功率半导体性能提供了解决方案

韩国首尔2024年9月11日 /美通社/ -- 韩国8英寸纯晶圆代工厂SK启方半导体(SK keyfoundry)今天宣布推出其第四代0.18微米BCD工艺，性能较之前的第三代提升了约20%。借此，SK启方半导体为提高移动和汽车功率半导体性能提供了解决方案。

SK启方半导体的第四代0.18微米BCD工艺提供高达40V的功率器件，并支持多种功率器件栅极输入电压，如3.3V、5V和18V，可应用于多种场景，例如服务器和笔记本电脑PMIC、DDR5内存PMIC、移动充电器、音频放大器和汽车栅极驱动器等，以满足客户需求。此外还提供MTP（可多次编程）/OTP（一次性编程）存储器、SRAM存储器等选项，帮助客户更好地进行产品设计。

SK启方半导体的第四代0.18微米BCD工艺符合汽车质量标准AEC-Q100 Grade 1，确保集成电路(IC)能在125°C的高温环境下稳定运行，适用于汽车功率半导体，厚IMD（金属间介质）选项使得汽车产品设计能够承受超过15,000V的电压。

凭借从第三代0.18微米BCD工艺中积攒的量产经验以及客户的高度信任，该公司期望第四代0.18微米BCD工艺能够帮助延长移动设备的电池寿命、通过减少发热实现稳定的性能，并通过提高汽车用功率半导体的能源效率来改善整体性能。

SK启方半导体首席执行官Derek D. Lee表示："我们很高兴能够为客户提供性能更好的全新第四代0.18微米BCD工艺。SK启方半导体将继续加强在功率半导体工艺技术方面的竞争力，并与客户紧密合作，将业务拓展到未来有望实现高速增长的各种应用领域，例如AI服务器PMIC、DDR5 PMIC、汽车栅极驱动IC等。"

原文地址：<http://www.china-nengyuan.com/news/215262.html>